



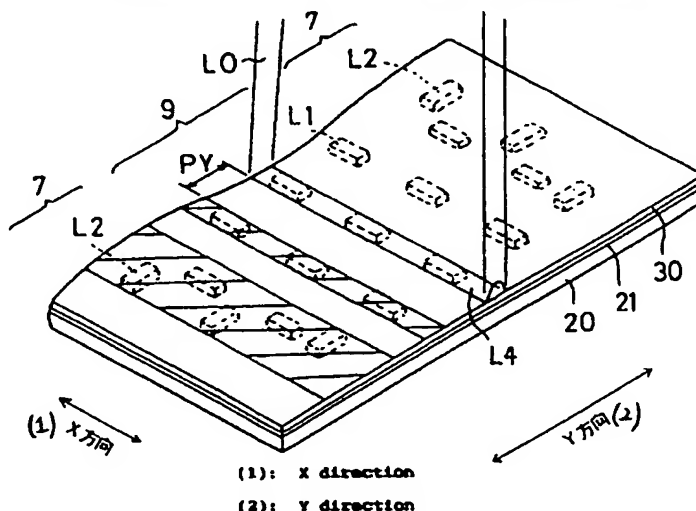
PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 G02F 1/136		A1	(11) 国際公開番号 WO97/23806
			(43) 国際公開日 1997年7月3日(03.07.97)
(21) 国際出願番号 PCT/JP96/03809		(81) 指定国 JP, KR, US.	
(22) 国際出願日 1996年12月26日(26.12.96)		添付公開書類 国際調査報告書	
(30) 優先権データ 特願平7/339749 1995年12月26日(26.12.95) JP			
(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) セイコーエプソン株式会社 (SEIKO EPSON CORPORATION)[JP/JP] 〒163 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 Tokyo, (JP)			
(72) 発明者：および (75) 発明者／出願人 (米国についてのみ) 東清一郎(HIGASHI, Seiichiro)[JP/JP] 〒392 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内 Nagano, (JP)			
(74) 代理人 弁理士 鈴木喜三郎, 外(SUZUKI, Kisaburo et al.) 〒163 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 セイコーエプソン株式会社内 Tokyo, (JP)			

(54)Title: ACTIVE MATRIX SUBSTRATE, PRODUCTION METHOD OF ACTIVE MATRIX SUBSTRATE, LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(54)発明の名称 アクティブマトリクス基板、アクティブマトリクス基板の製造方法、液晶表示装置、及び電子機器



(57) Abstract

In a laser anneal processing for an amorphous silicon film (30) formed on the surface of a substrate (20), a line beam L0 whose laser beam irradiation area L4 is elongated in an X direction and whose half width in a laser beam intensity profile in the Y direction is narrower than a pixel pitch in the Y direction is applied to the silicon film (30). When the position of the line beam L0 is fixed and the substrate (20) is moved by a stage in the Y direction, the moving speed is decreased when the line beam L0 irradiates a formation area A1 of a TFT (10) in the active matrix portion, and is increased when it irradiates other unnecessary portions. When a formation schedule area A2 of a data driver portion (7) is irradiated, this area is annealed by a laser as a whole because the TFTs (10) are arranged in a complexed way.